

Список публикаций официального оппонента

Власенко Леонида Сергеевича, д. ф.-м. н., главный научный сотрудник лаб. спиновых и оптических явлений в полупроводниках, ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.

1. **Vlasenko, L.S.** Effects of Spin-Dependent Recombination and EPR Spectroscopy of the Excited Triplet States of Point Defects in Silicon / **L.S. Vlasenko** // *Appl. Magn. Reson.* – 2016. Vol. 47. – P. 813.
2. Mortemousque, P.A. Quadrupole shift of nuclear magnetic resonance of donors in silicon at low magnetic field / P.A. Mortemousque, S. Rosenius, G. Pica, D.P. Franke, T. Sekiguchi, A. Truong, M.P. Vlasenko, **L.S. Vlasenko**, M.S. Brandt, R.G. Elliman, K.M. Itoh // *Nanotechnology*. – 2016. Vol. 27. – №. 49. – P. 494001.
3. Järvinen, J. Dynamic Polarization and Relaxation of ^{75}As Nuclei in Silicon at High Magnetic Field and Low Temperature / J. Järvinen, J. Ahokas, S. Sheludiakov, O. Vainio, D. Zvezdov, L. Lehtonen, **L. Vlasenko**, S. Vasiliev // *Appl. Magn. Reson.* – 2017. Vol. 48. – P. 473.
4. S. Hayashi, Electron spin resonance identification di-carbon-related centers in irradiated silicon / S. Hayashi, H. Saito, K.M. Itoh, M.P. Vlasenko, **L.S. Vlasenko** // *J. Appl. Phys.* – 2018. Vol. 123. – P. 161592.
5. Saito, H. Electron spin resonance study of surface and oxide interface spin-triplet centers on (100) silicon wafers / H. Saito, S. Hayashi, Y. Kusano, K.M. Itoh, M.P. Vlasenko, **L.S. Vlasenko** // *J. Appl. Phys.* – 2018. Vol. 123. – P. 161582.
6. Järvinen, J. Dynamic nuclear polarization and ESR hole burning in As doped silicon / J. Järvinen, D. Zvezdov, J. Ahokas, S. Sheludiakov, L. Lehtonen, S. Vasiliev, **L. Vlasenko**, Y. Ishikawa, Y. Fujii // *Phys. Chem. Chem. Phys.* – 2020. Vol. 22. – P. 10227.
7. Lutsev, L.V. Spin excitations in laser-molecular-beam epitaxy-grown nanosized YIG films: towards low relaxation and desirable magnetization profile / L.V. Lutsev, A.M. Korovin, S.M. Suturin, **L.S. Vlasenko**, M.P. Volkov, N.S. Sokolov // *J. Phys. D-Appl. Phys.* – 2020. Vol. 53. – №. 26. – P. 265003.